

### パワートランジスタモジュール

#### POWER TRANSISTOR MODULE

#### ■ 特長 : Features

- フリーホイリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- hFEが高い High DC Current Gain
- 絶縁形 Insulated Type

#### ■ 用途 : Applications

- 大電力スイッチング High Power Switching
- ACモータ制御 AC Motor Controls
- DCモータ制御 DC Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

#### ■ 定格と特性: Maximum ratings and characteristic

##### ● 絶対最大定格

Absolute maximum ratings (Tc=25°C unless otherwise specified)

Item	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CB0</sub>	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CE0</sub>	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CE0(SUS)</sub>	450	V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EB0</sub>	6	V
コレクタ電流	DC	I <sub>C</sub>	50 A
	1ms	I <sub>CP</sub>	100 A
	DC	-I <sub>C</sub>	50 A
ベース電流	DC	I <sub>B</sub>	3 A
	1ms	I <sub>BP</sub>	6 A
コレクタ損失	one Transistor	P <sub>C</sub>	300 W
	two Transistor	P <sub>C</sub>	600 W
接合部温度	T <sub>j</sub>	+150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-40 to +125	°C
質量	m	190	g
絶縁耐圧	AC.1min	Viso	2000 V
締付けトルク	Mounting *1	3.5	N·m
	Terminal *2	1.7	N·m

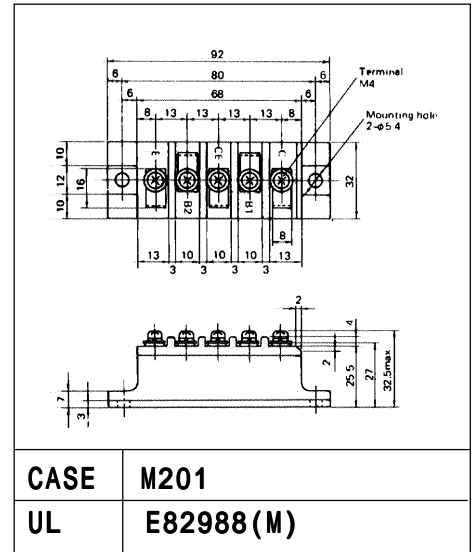
##### ● 電気的特性 : Electrical characteristics (Tc =25°C unless otherwise specified)

Item	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CB0</sub>	I <sub>CBO</sub> = 1mA	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CE0</sub>	I <sub>C</sub> = 1mA	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CE0(SUS)</sub>	I <sub>C</sub> = 1A	450			V
	V <sub>CEX(SUS)</sub>	I <sub>C</sub> =50A, V <sub>EB</sub> =6V, V <sub>CE</sub> =500V, I <sub>B</sub> =1A, -I <sub>B</sub> =5A	500			V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EB0</sub>	I <sub>EBO</sub> = 200mA	6			V
コレクタしゃ断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB0</sub> = 600V			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB0</sub> = 6V			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	-V <sub>CE</sub>	-I <sub>C</sub> = 50A			1.5	V
直流電流増幅率	hFE	I <sub>C</sub> = 50A, V <sub>CE</sub> = 5V	100			-
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(Sat)</sub>	I <sub>C</sub> = 50A, I <sub>B</sub> = 1A			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V <sub>BE(Sat)</sub>				2.5	V
スイッチング時間	t <sub>on</sub>	I <sub>C</sub> = 50A, P <sub>W</sub> =50μs,			3.0	μs
	t <sub>stg</sub>	I <sub>B1</sub> = +1A, I <sub>B2</sub> = -1A			12.0	μs
	t <sub>f</sub>	R <sub>L</sub> = 6Ω, Duty ≤ 2%			4.0	μs
逆回復時間	t <sub>rr</sub>	-I <sub>C</sub> = 50A, V <sub>BE</sub> = -6V, -di/dt = 50A/μs			0.6	

##### ● 熱的特性 : Thermal characteristics

Item	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
熱抵抗	R <sub>th(j-c)</sub>	Transistor			0.41	°C/W
	R <sub>th(j-c)</sub>	Diode			1.3	°C/W
	R <sub>th(c-f)</sub>	With Thermal Compound		0.05		°C/W

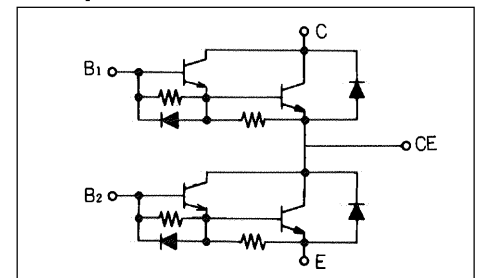
#### ■ 外形寸法: Outline Drawings



CASE	M201
UL	E82988 (M)

#### ■ 等価回路:

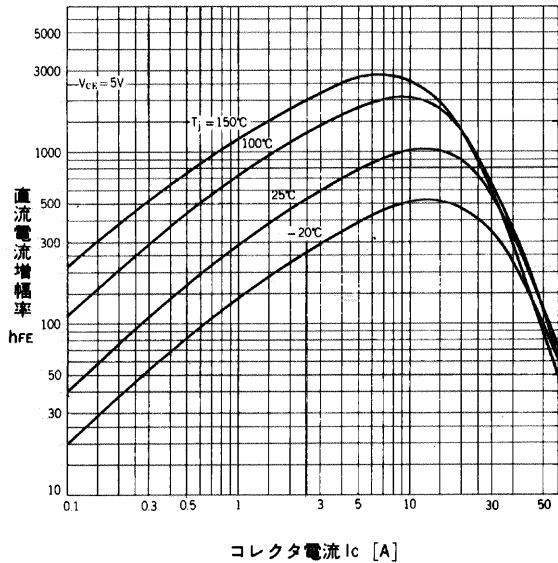
##### Equivalent Circuit Schematic



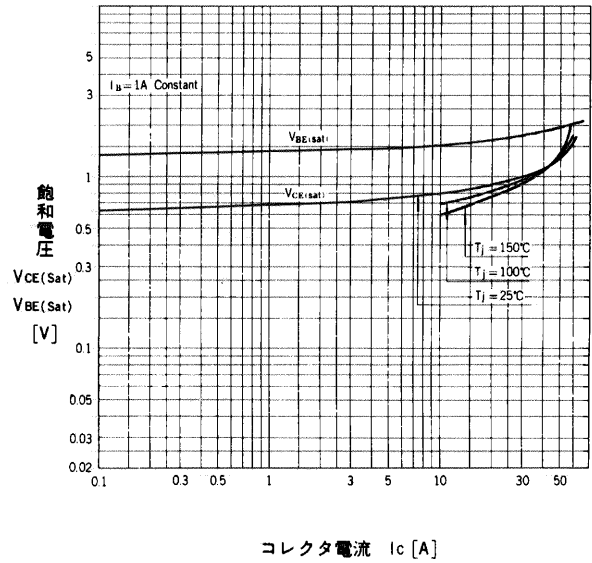
Note:

- \*1: 推奨値 Recommendable Value;  
2.5to3.0N·m[25to30kgf·cm] (M5)
- \*2: 推奨値 Recommendable Value;  
1.4to1.6N·m[14to16kgf·cm] (M4)

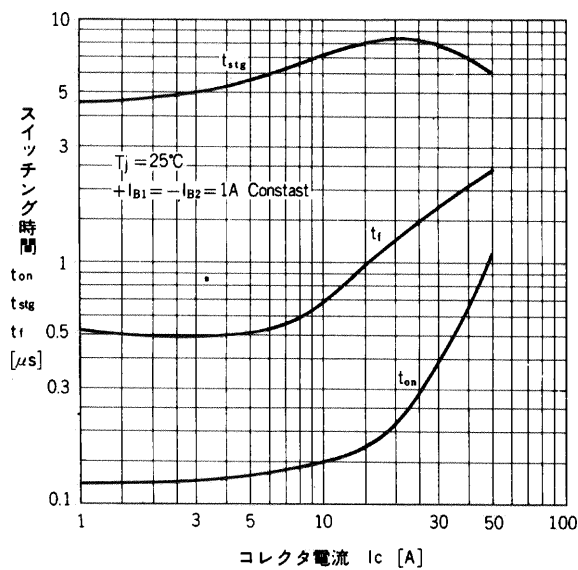
■ 特性曲線 : Characteristics



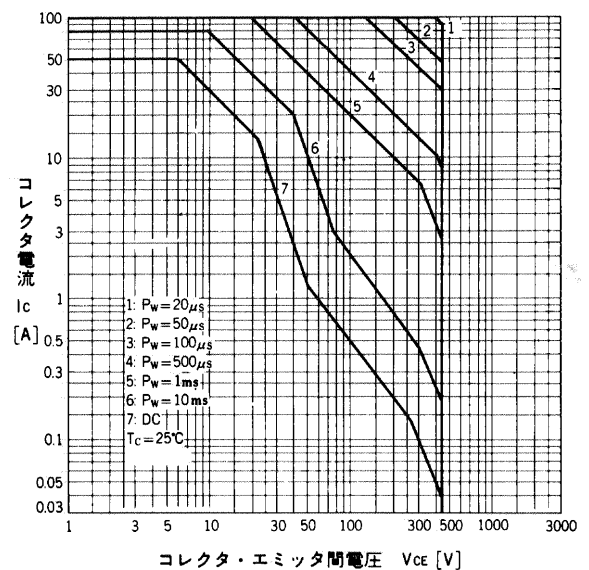
直流電流増幅率-コレクタ電流特性  
DC Current Gain



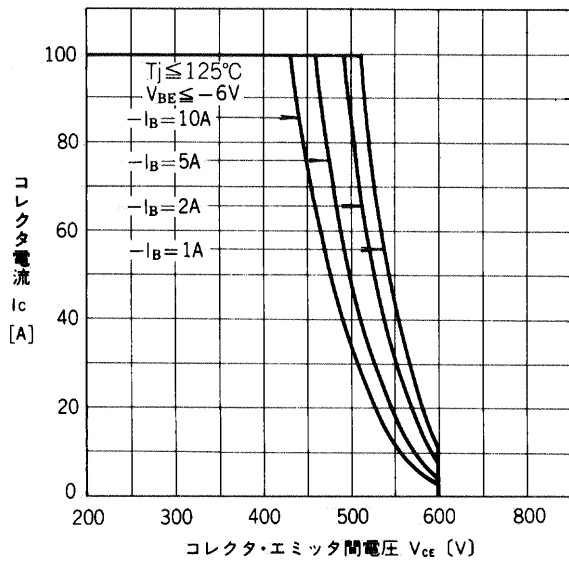
飽和電圧-コレクタ電流特性  
Base and Collector Saturation Voltage



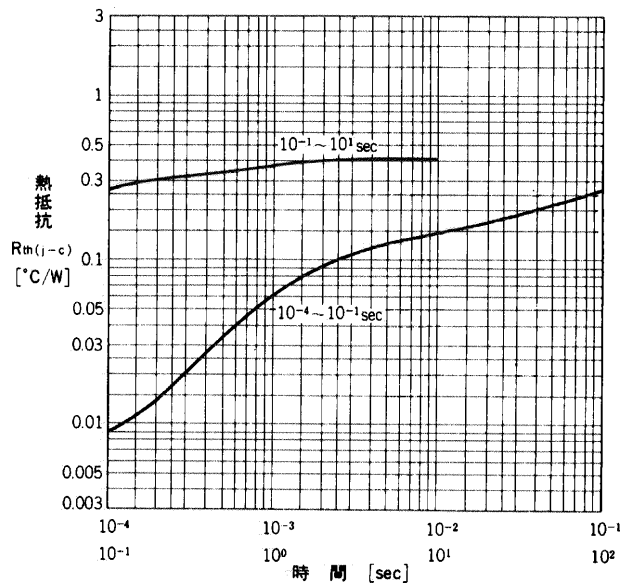
スイッチング時間-コレクタ電流特性  
Switching Time



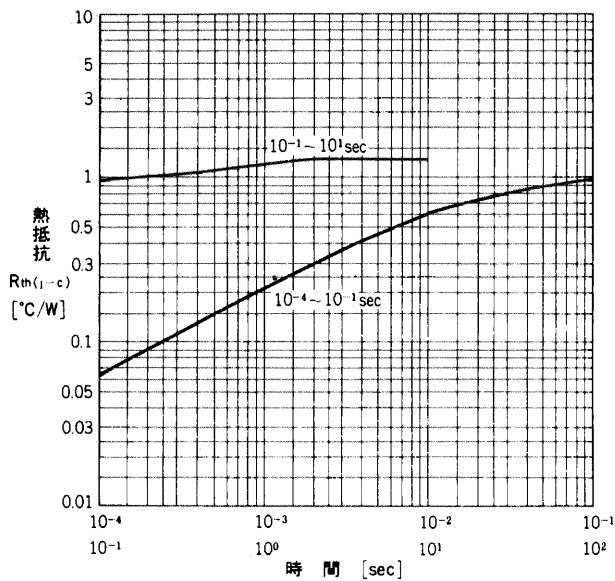
安全動作領域特性 (繰返し)  
Safe Operating Area



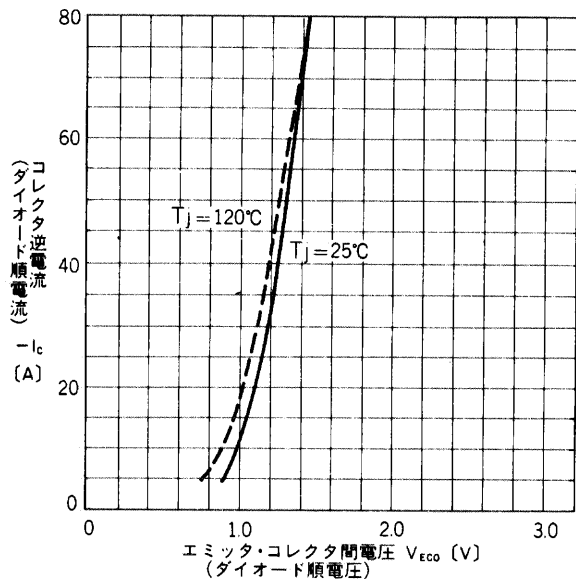
**安全動作領域特性(逆バイアス)**  
Reversed Biased Safe Operating Area



**過渡熱抵抗(トランジスタ)特性**  
Transient Thermal Resistance (Transistor)



**過渡熱抵抗(ダイオード)特性**  
Transient Thermal Resistance (Diode)



**高速フリーホイリングダイオード順電圧**  
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

\* Switching Time Test Circuit

